

09/214708
01-11-99

世界知的所有権機関
国際事務局



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類6 H01L 21/3065, 21/304, 21/205, 21/31, C23C 16/44, 16/50, C07C 19/08, 49/167, C07D 303/08</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO98/01899</p> <p>(43) 国際公開日 1998年1月15日(15 01.98)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/02369</p> <p>(22) 国際出願日 1997年7月9日(09.07.97)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平8/180518 1996年7月10日(10.07.96) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)(JP/JP) 〒530 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ) 板野充司(ITANO, Mitsushi)(JP/JP) 〒566 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 三枝英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.) 〒541 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 北浜TNKビル Osaka, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54) Title: CLEANING GAS</p> <p>(54) 発明の名称 クリーニングガス</p> <p>(57) Abstract A chamber cleaning gas for Si films, SiO₂ films, Si₃N₄ films or high-melting metal silicide films, which comprises at least one gas selected from the group consisting of those represented by formulac: (a), (b) and (c); and a process for cleaning a chamber.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> $\text{CF}_3\text{CF}=\text{CF}_2$ <p>(a)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(b)</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{CF}_3\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{CF}_3 \end{array}$ <p>(c)</p> </div> </div>		

PCT/JP97/02369